

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Invertitori CMOS Formule

[Calcolatrici!](#)[Esempi!](#)[Conversioni!](#)

Segnalibro calculatoratoz.com, unitsconverters.com

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità costruita!**
La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Lista di 16 Invertitori CMOS Formule

Invertitori CMOS ↗

1) Capacità di carico del CMOS dell'inverter in cascata ↗

fx $C_{load} = C_{gd,p} + C_{gd,n} + C_{db,p} + C_{db,n} + C_{in} + C_g$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.93\text{fF} = 0.15\text{fF} + 0.1\text{fF} + 0.25\text{fF} + 0.2\text{fF} + 0.05\text{fF} + 0.18\text{fF}$

2) Carico resistivo Tensione di ingresso massima CMOS ↗

fx $V_{IL(RL)} = V_{T0} + \left(\frac{1}{K_n \cdot R_L} \right)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $1.4025\text{V} = 1.4\text{V} + \left(\frac{1}{200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot 2\text{M}\Omega} \right)$

3) Carico resistivo Tensione di ingresso minima CMOS ↗

fx $V_{IH(RL)} = V_{T0} + \sqrt{\frac{8 \cdot V_{DD}}{3 \cdot K_n \cdot R_L}} - \left(\frac{1}{K_n \cdot R_L} \right)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $1.545824\text{V} = 1.4\text{V} + \sqrt{\frac{8 \cdot 3.3\text{V}}{3 \cdot 200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot 2\text{M}\Omega}} - \left(\frac{1}{200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot 2\text{M}\Omega} \right)$

4) Carico resistivo Tensione di uscita minima CMOS ↗

fx $V_{OL(RL)} = V_{DD} - V_{T0} + \left(\frac{1}{K_n \cdot R_L} \right) - \sqrt{\left(V_{DD} - V_{T0} + \left(\frac{1}{K_n \cdot R_L} \right) \right)^2 - \left(2 \cdot \frac{V_{DD}}{K_n \cdot R_L} \right)}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $0.004341\text{V} = 3.3\text{V} - 1.4\text{V} + \left(\frac{1}{200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot 2\text{M}\Omega} \right) - \sqrt{\left(3.3\text{V} - 1.4\text{V} + \left(\frac{1}{200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot 2\text{M}\Omega} \right) \right)^2 - \left(2 \cdot \frac{3.3}{200} \right)}$



5) CMOS di tensione di soglia ↗

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{fx } V_{\text{th}} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\frac{1}{K_r} \cdot (V_{\text{DD}} + (V_{T0,p}))}}{1 + \sqrt{\frac{1}{K_r}}}$$

$$\text{ex } 1.374852\text{V} = \frac{0.6\text{V} + \sqrt{\frac{1}{2.5} \cdot (3.3\text{V} + (-0.7\text{V}))}}{1 + \sqrt{\frac{1}{2.5}}}$$

6) CMOS media della dissipazione di potenza ↗

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{fx } P_{\text{avg}} = C_{\text{load}} \cdot (V_{\text{DD}})^2 \cdot f$$

$$\text{ex } 0.404095\text{mW} = 0.93\text{fF} \cdot (3.3\text{V})^2 \cdot 39.9\text{GHz}$$

7) Margine di rumore per CMOS a segnale elevato ↗

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{fx } N_{\text{MH}} = V_{\text{OH}} - V_{\text{IH}}$$

$$\text{ex } 1.8\text{V} = 3.35\text{V} - 1.55\text{V}$$

8) Massima tensione di ingresso CMOS ↗

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{fx } V_{\text{IL}} = \frac{2 \cdot V_{\text{output}} + (V_{T0,p}) - V_{\text{DD}} + K_r \cdot V_{T0,n}}{1 + K_r}$$

$$\text{ex } 1.08\text{V} = \frac{2 \cdot 3.14\text{V} + (-0.7\text{V}) - 3.3\text{V} + 2.5 \cdot 0.6\text{V}}{1 + 2.5}$$

9) Oscillatore ad anello del periodo di oscillazione CMOS ↗

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{fx } T_{\text{osc}} = 2 \cdot n \cdot \zeta_p$$

$$\text{ex } 0.0252\text{ns} = 2 \cdot 3 \cdot 0.0042\text{ns}$$

10) Rapporto di transconduttanza CMOS ↗

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$\text{fx } K_r = \frac{K_n}{K_p}$$

$$\text{ex } 2.5 = \frac{200\mu\text{A}/\text{V}^2}{80\mu\text{A}/\text{V}^2}$$



11) Ritardo di propagazione per CMOS di transizione con uscita da bassa ad alta ↗

fx

Apri Calcolatrice ↗

$$\zeta_{PLH} = \left(\frac{C_{load}}{K_p \cdot (V_{DD} - |V_{T,p}|)} \right) \cdot \left(\left(\frac{2 \cdot |V_{T,p}|}{V_{DD} - |V_{T,p}|} \right) + \ln \left(\left(4 \cdot \frac{V_{DD} - |V_{T,p}|}{V_{DD}} \right) - 1 \right) \right)$$

ex $0.006765\text{ns} = \left(\frac{0.93\text{fF}}{80\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot (3.3\text{V} - |-0.9\text{V}|)} \right) \cdot \left(\left(\frac{2 \cdot |-0.9\text{V}|}{3.3\text{V} - |-0.9\text{V}|} \right) + \ln \left(\left(4 \cdot \frac{3.3\text{V} - |-0.9\text{V}|}{3.3\text{V}} \right) - 1 \right) \right)$

12) Ritardo di propagazione per la transizione CMOS da alto a basso output ↗

fx

Apri Calcolatrice ↗

$$\zeta_{PHL} = \left(\frac{C_{load}}{K_n \cdot (V_{DD} - V_{T,n})} \right) \cdot \left(\left(2 \cdot \frac{V_{T,n}}{V_{DD} - V_{T,n}} \right) + \ln \left(\left(4 \cdot \frac{V_{DD} - V_{T,n}}{V_{DD}} \right) - 1 \right) \right)$$

ex $0.002508\text{ns} = \left(\frac{0.93\text{fF}}{200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot (3.3\text{V} - 0.8\text{V})} \right) \cdot \left(\left(2 \cdot \frac{0.8\text{V}}{3.3\text{V} - 0.8\text{V}} \right) + \ln \left(\left(4 \cdot \frac{3.3\text{V} - 0.8\text{V}}{3.3\text{V}} \right) - 1 \right) \right)$

13) Ritardo medio di propagazione CMOS ↗

fx $\zeta_P = \frac{\zeta_{PHL} + \zeta_{PLH}}{2}$

Apri Calcolatrice ↗

ex $0.004236\text{ns} = \frac{0.00229\text{ns} + 0.006182\text{ns}}{2}$

14) Tensione di ingresso massima per CMOS simmetrico ↗

fx $V_{IL(\text{sym})} = \frac{3 \cdot V_{DD} + 2 \cdot V_{T0,n}}{8}$

Apri Calcolatrice ↗

ex $1.3875\text{V} = \frac{3 \cdot 3.3\text{V} + 2 \cdot 0.6\text{V}}{8}$

15) Tensione di ingresso minima CMOS ↗

fx $V_{IH} = \frac{V_{DD} + (V_{T0,p}) + K_r \cdot (2 \cdot V_{out} + V_{T0,n})}{1 + K_r}$

Apri Calcolatrice ↗

ex $1.557143\text{V} = \frac{3.3\text{V} + (-0.7\text{V}) + 2.5 \cdot (2 \cdot 0.27\text{V} + 0.6\text{V})}{1 + 2.5}$



16) Tensione di ingresso minima per CMOS simmetrico [Apri Calcolatrice](#) 

fx $V_{IH(\text{sym})} = \frac{5 \cdot V_{DD} - 2 \cdot V_{T0,n}}{8}$

ex $1.9125V = \frac{5 \cdot 3.3V - 2 \cdot 0.6V}{8}$



Variabili utilizzate

- $C_{db,n}$ Capacità di massa di drain NMOS (*Femtofarad*)
- $C_{db,p}$ Capacità di massa di drenaggio PMOS (*Femtofarad*)
- C_g Capacità del gate CMOS dell'inverter (*Femtofarad*)
- $C_{gd,n}$ Capacità di drain del gate NMOS (*Femtofarad*)
- $C_{gd,p}$ Capacità di drenaggio del gate PMOS (*Femtofarad*)
- C_{in} Capacità interna CMOS dell'inverter (*Femtofarad*)
- C_{load} Capacità di carico CMOS dell'inverter (*Femtofarad*)
- f Frequenza (*Gigahertz*)
- K_n Transconduttanza di NMOS (*Microampere per Volt Quadrato*)
- K_p Transconduttanza del PMOS (*Microampere per Volt Quadrato*)
- K_r Rapporto di transconduttanza
- n Oscillatore ad anello con numero di stadi
- N_{MH} Margine di rumore per segnale alto (*Volt*)
- P_{avg} Dissipazione di potenza media (*Milliwatt*)
- R_L Resistenza al carico (*Megahm*)
- T_{osc} Periodo di oscillazione (*Nanosecondo*)
- V_{DD} Tensione di alimentazione (*Volt*)
- V_{IH} Tensione di ingresso minima (*Volt*)
- $V_{IH(RL)}$ Tensione di ingresso minima del carico resistivo (*Volt*)
- $V_{IH(sym)}$ CMOS simmetrico con tensione di ingresso minima (*Volt*)
- V_{IL} Massima tensione di ingresso CMOS (*Volt*)
- $V_{IL(RL)}$ Carico resistivo Tensione di ingresso massima CMOS (*Volt*)
- $V_{IL(sym)}$ CMOS simmetrico con tensione di ingresso massima (*Volt*)
- V_{OH} Tensione di uscita massima (*Volt*)
- $V_{OL(RL)}$ Tensione di uscita minima del carico resistivo (*Volt*)
- V_{out} Tensione di uscita (*Volt*)
- V_{output} Tensione di uscita per ingresso massimo (*Volt*)
- $V_{T,n}$ Tensione di soglia di NMOS con polarizzazione del corpo (*Volt*)
- $V_{T,p}$ Tensione di soglia del PMOS con polarizzazione del corpo (*Volt*)
- V_{T0} Tensione di soglia di polarizzazione zero (*Volt*)
- $V_{T0,n}$ Tensione di soglia di NMOS senza polarizzazione del corpo (*Volt*)
- $V_{T0,p}$ Tensione di soglia del PMOS senza polarizzazione del corpo (*Volt*)



- V_{th} Soglia di voltaggio (Volt)
- ζ_P Ritardo medio di propagazione (Nanosecondo)
- ζ_{PHL} Tempo per la transizione da alto a basso dell'output (Nanosecondo)
- ζ_{PLH} Tempo per la transizione da basso ad alto dell'output (Nanosecondo)



Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Funzione:** **abs**, abs(Number)

Il valore assoluto di un numero è la sua distanza dallo zero sulla linea numerica. È sempre un valore positivo, poiché rappresenta la grandezza di un numero senza considerarne la direzione.

- **Funzione:** **ln**, ln(Number)

Il logaritmo naturale, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.

- **Funzione:** **sqrt**, sqrt(Number)

Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.

- **Misurazione:** **Tempo** in Nanosecondo (ns)

Tempo Conversione unità 

- **Misurazione:** **Potenza** in Milliwatt (mW)

Potenza Conversione unità 

- **Misurazione:** **Frequenza** in Gigahertz (GHz)

Frequenza Conversione unità 

- **Misurazione:** **Capacità** in Femtofarad (fF)

Capacità Conversione unità 

- **Misurazione:** **Resistenza elettrica** in Megahm ($M\Omega$)

Resistenza elettrica Conversione unità 

- **Misurazione:** **Potenziale elettrico** in Volt (V)

Potenziale elettrico Conversione unità 

- **Misurazione:** **Parametro di transconduttanza** in Microampere per Volt Quadrato ($\mu A/V^2$)

Parametro di transconduttanza Conversione unità 



Controlla altri elenchi di formule

- Sottosistema del percorso dati dell'array Formule ↗
- Caratteristiche del circuito CMOS Formule ↗
- Caratteristiche di ritardo CMOS Formule ↗
- Caratteristiche del progetto CMOS Formule ↗
- Invertitori CMOS Formule ↗
- Metriche di potenza CMOS Formule ↗
- Sottosistema CMOS per scopi speciali Formule ↗
- Caratteristiche temporali CMOS Formule ↗

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

5/27/2024 | 9:07:49 AM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

